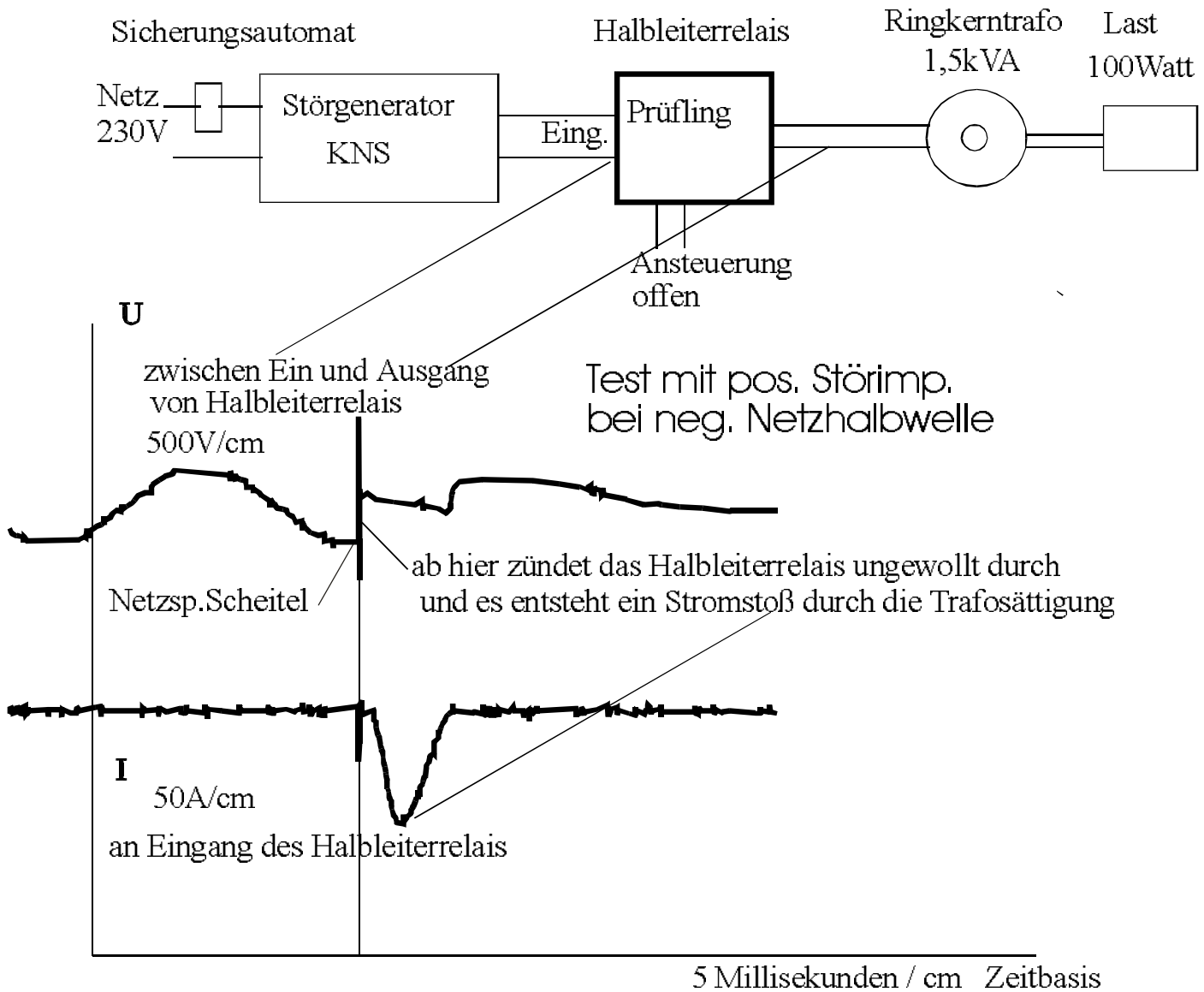


Prüfaufbau für Störfestigkeitprüfung von Halbleiter - relais

Überlagern der Netzspannung im pos.Scheitel, alle 2 Sekunden,
mit pos. u. neg. Störimpulsen von 0 bis 3 kV Amplitude und mit 20 Microsekunden Dauer.
Prüfkriterium: Ab welcher Amplitude die Halbleiterrelais ungewollt leitend werden,
durch die Störimpulse. Wenn das der Fall ist, entsteht ein Überstrom durch den
Trafo, der durch den sich wiederholenden Vorgang in Sättigung getrieben wird.
(nach dem Registrieren des Bildes wurde die Sicherung ausgelöst.)



Parameter: Prüfling: TSE 6.1 mit 2 Sitac, 330ohm i.R., 0,022myf üb Thyr., bei 230V Netzsp.,
Ergebnis: bei 3kV zündet TSE durch bei Test nach 1b, b.neg. Störimp.

Bei allen anderen Prüf-Einstellungen am KNS ist kein Fehler aufgetreten.

bei 0,15 Myf + 47 Ohm über Thyr. entsteht kein Durchzünden mehr.